



東京都市大学は24日、
ゲルマニウム製の微小な
半導体粒子（量子ドッ
ト）を使った、高効率な
電流注入型の発光素子を
試作した。電流注入型の發
光素子（ $\mu\text{m} \times \text{マイクロ}$
メートル）

室温で高効率な発光素子 量子ドット使い開発

東京都市大

開発したと発表した。室温下で外部から電流を流すと自ら発光する。室温で発振するシリコンレー
ザーの実用化が近づく。今後2年後をめどに、光配線に応用し、光と電子を融合した次世代LSIの原理実証を目指す。分

波長領域は光通信に適した1・3・8・1・6・8μm帯で、既存の相補型金属酸化膜半導体(CMO S)プロセスと互換性がある仕組み。室温で鋭い発光特性を示す。

子線エビタキシャル成長(MBE)で作製した直径約100ナノ（ナノは10億分の1）のゲルマニウム量子ドットを、発光が外に漏れないように、新開発の微小な円形構造（マイクロディスク）構造に埋め込んだ。マイクロディスクの直徑を発光波長と同程度まで微細化すると、ディスク内部で発光が円周方向に共振し、光の強度が増幅される仕組み。室温で鋭い発光特性を示す。

シリコンナノ科学研究センター長は「シリコンレ

ーザーの幕開けにつながる成果だ」と語る。